



Транзистор 2Т825/2

ОКП 63 4120

ЭТИКЕТКА

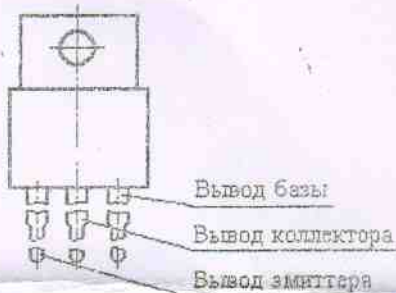
ЮФ3.365.127-04 ЭТ

Кремниевые меза-планарные составные р-п-р транзисторы 2Т825А2, 2Т825В2, 2Т825В2 в пластмассовом корпусе КТ-28-2 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в ключевых и линейных схемах аппаратуры специального назначения групп исполнения 1.1, 1.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.2.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ.20.39.304-98 с индивидуальной защитой или общей герметизацией.

Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Сертификат ЦОС "Военэлектронсерт"
ФГУ "22 ЦНИИ Минобороны России"
№ СВС.01.431.0159.08

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при $t_{обс} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{кз} = 10 \text{ В}$, $I_2 = 10 \text{ А}$) 2Т825А2 2Т825В2, 2Т825В2	$h_{21э}$	500 750	18000 18000
Обратный ток коллектор-эмиттер, ($U_{бэ} = 1,5 \text{ В}$), мА ($U_{кзх} = 100 \text{ В}$) 2Т825А2 ($U_{кзх} = 80 \text{ В}$) 2Т825В2 ($U_{кзх} = 60 \text{ В}$) 2Т825В2	$I_{кэх}$		1 1 1
Граничное напряжение, ($I_к = 100 \text{ мА}$, $\tau_и = 1 \text{ мс} \pm 10\%$), В 2Т825А2 2Т825В2 2Т825В2	$U_{кэо гр}$	80 60 45	
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, ($I_к = 1 \text{ мА}$, $U_{бэ} = 1,5 \text{ В}$), В 2Т825А2 2Т825В2 2Т825В2	$U_{кэх проб}$	100 80 60	
Пробивное напряжение эмиттер-база, ($I_2 = 2 \text{ мА}$), В	$U_{эбо проб}$	5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_к = 10 \text{ А}$, $I_э = 0,04 \text{ А}$), В	$U_{кэ нас}$		2
Напряжение насыщения база-эмиттер, ($I_к = 10 \text{ А}$, $I_э = 0,04 \text{ А}$), В	$U_{бэ нас}$		3

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

золото 0,0347 г
серебро 0,255 г

1.3 Содержание цветных металлов:

медь – 1,53 г в одном транзисторе.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, тока и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений, $t_{горн} \leq 25^\circ\text{C} - 50000 \text{ ч}$.

2.2 Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 50000 ч, а в облегченном режиме – 80000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или во всех местах хранения транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплексе ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке изготовителя или смонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплексе ЗИП в неотанпливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальный срок сохраняемости соответствует ГОСТ В 28146-89.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям АА0.339.556 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок – 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки транзисторов – с даты перепроверки. Гарантийная наработка:

25000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
50000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т825А2, 2Т825В2, 2Т825В2 соответствуют техническим условиям АА0.339.556 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 8 от 2.06.10г. дата

Место для штампа СКК



Место для штампа ВП

Место для штампа "Перепроверка произведена" дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа СКК

Место для штампа ВП

Цена договорная